文章编号: 1001-3806(2006)06-0618-03

调幅式调制盘红外导引头的主动干扰

王 滨^{1,2},李 彤,吕百达^{1*},钟 鸣²

(1. 四川大学 激光物理与化学研究所, 成都 610064; 2 西南技术物理研究所, 成都 610041)

摘要: 为了干扰调幅式调制盘系统,根据调幅式调制盘红外导引头的工作原理,采用数值模拟的方式分析了两种主 动干扰红外导引头的方法。结果表明,缓变幅度的干扰辐射会使导引头获得的目标方位信息产生偏差,但无法使目标摆 脱导引头的跟踪: 而重复频率近似等于调制盘系统调制波形载频的光脉冲会干扰导引头接收到的目标信号, 使导引头失 去目标。干扰辐射强度近似等于目标辐射强度,即可实现干扰。

关键词: 激光技术; 红外导引头; 干扰; 调制盘 中图分类号: TN 216 文献标识码: A

A ctive jamming of an infrared seeker with amplitude modulation reticle

WANG $Bin^{1/2}$, $LITong^2$, $L\ddot{U}Bairda^1$, $ZHONG Ming^2$ (1. Institute of Laser Physics and Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064, China 2. Southwest Institute of Technical Physics, Chengdu 610041, China)

Abstract For the purpose of jamming the amplitude modulation reticle system, two methods of active jamming of infrared seeker are analyzed by using numerical simulation based on the operation principle of an infrared seeker with amplitude modulation reticle. The results show that the jamming source with a slow variation of amplitude will warp the target's azimuth received by the seeker But it can not make the target escape from the scout of the seeker At a repetition rate nearly equal to the carrier frequency of the reticle system, the jamming source will a surb the target's signal received by the seeker, and make the seeker bse the target If the intensity of the jamming source nearly equals to that of target's radiation, the jamming can be achieved

Keywords laser technique, infrared seeker, janming modulation reticle

引 言

红外点源寻的跟踪制导武器是最早研制的红外制 导武器。其技术难度较低,而效费比相对较高,这使得 它并未因成像寻的制导的出现而迅速退役。目前服役 的导弹,仍以红外点源寻的者居多^[1]。

点源跟踪制导系统根据目标的热辐射特性,把目 标当作热辐射点进行探测。调制盘是多数点源制导系 统的核心元件,其主要作用是:把恒定的辐射通量变成 交变的辐射通量,以便用交流放大器把信号放大,进行 空间滤波,抑制背景,突出目标及提供目标的方位信 息。按照像点在调制盘上的扫描方式,调制盘可分为 旋转调制盘、章动调制盘、圆锥扫描调制盘等;按调制 方式划分,调制盘又可分为调幅式、调频式、调相式、脉 冲编码式和脉冲调宽式等。本文中的研究对象为调幅

基金项目: 国防预研基金资助项目(51288)

作者简介: 王 滨 (1982-), 男, 硕士研究生, 主要从事中 红外定向干扰研究工作。

* 通讯联系人。 E-m ail baidah@ scu edu en 收稿日期: 2005-11-08 收到修改稿日期: 2006-02-16

式旋转调制盘。

主动式红外对抗系统向来袭导弹发射经调制的红 外辐射,使导弹无法正常跟踪目标。对调幅式调制盘 系统干扰方式主要有两种,一是引入幅度缓变的干扰 光,从而影响调幅式调制盘系统接受到的目标辐射信 号的幅值,使之得到错误的目标信息;二是发射一定频 率的红外光脉冲信号,通过调制盘的半透明区进入调 制盘系统,从而对目标调制信号产生干扰。干扰光源 可以采用传统红外光源,也可采用红外激光器进行定 向干扰^[2~4]。

1 调制盘系统制导原理分析

旭日式调制盘是最简单的调幅式调制盘,如图 1 所示。图中上半圆为目标像点调制区,由 6组圆心角 相同的透光与不透光扇形相间配置而成;下半圆为半 透明区^[5]。当目标像点落在调制盘边缘时,随调制盘 的转动探测器接受到周期性光脉冲,从而得到目标信 号。而当面积较大的背景进入视场时,由于其覆盖调 制区多个扇区,探测器接受到的透射通量近似为一恒 值,不会造成有用信号输出,从而起到空间滤波的作



Fig 1 Illustration of rising-sun reticle

用^[6]。假设目标像点为能量分布均匀的半径为 δ的圆 形,像点中心距离调制盘中心距离为 Q 则像点通过旭 日式调制盘后所形成的调制波解析式为^[7]:

$$F(t) = \frac{1}{2}F + F\sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{2 \mathbf{J}(nZ)}{nZ} \sin(n\theta + n\omega t) (1)$$

式中, *F* 为入射总 能量, ω 是调制 盘的转 速, $\theta = \theta_0 - \pi/2, \theta_0$ 为目标方位角, $\prod (nZ)$ 是以 *nZ* 为宗量的 第一类一阶贝塞尔函数, *Z* = $\delta/P, \tau(u)$ 是系统透过滤 函数, *B_u* 是透过函数 $\tau'(u)$ 的 *n*次协波的幅值:

 $B_n = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{n} \tau'(u) \sin u \, du, \ \tau'(u) = \tau(u) - \frac{1}{2} (2)$

像点透过调制盘的调制波形如图 2所示,其中T为调



Fig 2 Waveforms of facular energy methation 制盘转动 1周的时间, T = 2π /ω。如 (1)式所示的光信 号经探测器光电转换并放大转变为电信号,进入系统 滤波电路。对于如图 1所示的调制盘,调制区有 6组 黑白相间条幅,则透过调制盘的信号频率为 12ω,称为 调制盘系统的载频。为抑制背景及噪声,系统中一般 会加入一带通滤波器,从信号能量及信噪比考虑^[8], 滤波器一般取中心频率为 12ω,带宽为 2ω。设 $D_n = 2B_n J_1 (nZ) /nZ$,则 F(t)经过探测器光电转换,放大, 带通滤波后可写为:

 $U'(t) = KF / D_{11} \sin(11\theta + 11\omega t) +$

 $D_{12}\sin(12\theta+12\omega t) + D_{13}\sin(13\theta+13\omega t)]$ (3) 式中,*K* 是一比例系数,它与光电转换效率及放大系数 有关。当 Z < 1时,可近似认为 $D_{11} = D_{13}$,于是经检波 器取出包含有目标方位信息的包络信号可写为:

 $U(t) = KF[D_{12} + (D_{11} + D_B)\sin(\omega t - \theta_0)](4)$ 式中,正弦包络信号的幅值与目标的失调角有关,目标 离调制盘中心越远,振幅越大,包络初位相 θ_0 表征目标 在空间的方 位角,上式信号与基准信号 $U_b(t) =$ $U_{\rm b}(1+\sin\omega t)$ 相比较,即可得到目标失调角 Δq 和方位 角 $\theta_{\rm o}$

2 干扰对调制盘系统影响分析

为使计算简便,同时能比较不同干扰方式的干扰 效果,选取一组周期性正弦信号作为干扰光辐射信 号^[9]: $S(t) = S + mS\sin(\Omega t + \Phi)$ (5) 式中,S为干扰机的辐射能量, Ω 为干扰波形的角频 率, Φ 为干扰波形初相位,m为常数($m \leq 1$)。当 $\Omega \ll$ 12 ω 时,可认为上述是一幅值缓变的干扰光,用于干扰 调制盘系统接受到的光脉冲幅度;当 Ω 近似于 12 ω 时,认为上式可近似为一组光脉冲信号,用以干扰调制 盘系统接受到的目标信号。

将该辐射叠加到点源目标上,同时为调制盘接收 并调制,得到调制波形如下;

$$F(t) = \frac{(F+S)}{2} + F + S \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin(n\theta + n\omega t) + \frac{mS\sin(\Omega t + \varphi)}{2} + mS\sin(\Omega t + \varphi) \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin(n\theta + n\omega t)$$
(6)

式中,第一1项和第 2项能正确反映目标的位置信息,它 与(1)式相似,幅值是(1)式的(F+S)/F倍,这是由 干扰信号的直流项引起的,它对调制系统没有干扰作 用,反而增强了目标信号,使目标更容易暴露。第 3项 和第 4项是干扰项,将分别讨论其干扰机理及效果。

当干扰频率 Ω处于系统滤波器通带范围之外时, 第 3项干扰将被系统滤掉,第 4项起主要干扰作用,它 可以展开为:

$$F_{4}(t) = \frac{mS}{2} \sum_{n=1}^{\infty} D_{n} \{ \cos[(n\omega - \Omega)t + n\theta - \Psi] - \cos[(n\omega + \Omega)t + n\theta + \Psi] \}$$
(7)

上式在 n= 12左右协波幅值最大,即当 Ω≈ ω时,上述 辐射通量经过探测器光电转换放大,再经过带通滤波 器后得到电信号可写为:

 $U_{4}'(t) = m SKD_{12} \sin(\Omega t + \Psi) \sin(12\omega t + 12\theta) + m SKD_{11} \sin[(\Omega - \omega)t + \Psi - \theta] \sin(12\omega t + 12\theta)$ (8) L式经检波后得到干扰波形包络信号:

$$U_4(t) = mSKD_{12}\sin(\Omega t + \Psi) +$$

 $mSKD_{11} \sin[(\Omega - \omega)t + \Psi - \theta]$ (9) 调制波的包络波形中包含两种干扰正弦震荡,其初相 位分别是 $\Psi = \theta$ 幅值分别为 $mSKD_{12}$ 和 $mSKD_{13}$ 。

若 $11^{\omega} \leq \Omega \leq 13^{\omega}$, (6)式中的第 4项作为高频噪 声被滤波器滤掉,第 3项干扰波 $F_3(t) = mS\sin(\Omega t + \Phi)$ /2处于系统滤波器通带范围内时,经过光电转换, 放大电路,带通滤波电路和检波电路后得到信号电压: $U_3(t) = mSK\cos[(\Omega - 12^{\omega})t + \Phi - 12\theta]/4$ (10) 上式会引入干扰波信号包络,对目标信号包络产生干扰,甚至使目标信号淹没于干扰信号中,从而使导引头 丢失目标方位信息。

3 数值模拟计算

假设目标为一辐射能量恒定为 F 的像点, 它透过 调制盘系统的调制波形如图 3a所示, 图中取 $\theta_0 = 0$ 灰 线表示目标信号经光电转换, 放大和滤波后的调制信 号, 实线表示理论计算出的检波后的信号, 虚线表示基 准信号, 它由调制盘系统产生, 在图 3中均把基准信





a — no jamming b— $\Omega = 1$. 1 ω , S = F c— $\Omega = 1$. 1 ω , S = 10F

号幅值设定在信号幅值附近,以便于比较干扰对信号 幅值和位相的影响。图中可以看出,目标信号调制包 络与基准信号位相相差为 0,从而可以判断出目标像 点位于调制盘上 $\theta_i = 0$ 处,进而得到目标的空间方位 角;包络的幅值表示像点到调制盘中心的相对距离,若 像点位于调制盘中心,包络幅值为 0,由于 $D_{11} + D_{13} > D_{12}$,图中载波信号略微出现过调制现象。

对于幅值缓变的干扰辐射,假设 Q = 1 1 ω , *S* 分别 取 *F* 和 10*F*, $\theta_0 = 0$, $\varphi = \pi$,如图 34、图 3cm示,干扰信 号的直流分量增强了目标信息、同时干扰信号振幅的 变化影响了目标信息包络的幅值,部分周期内包络的 位相也有所改变,从而影响了导引头对目标方位的准 确判断,具有一定干扰作用,但上述干扰只是使导引头 获得的目标方位出现小的偏差,而无法使目标完全摆 脱导弹的跟踪。

对于红外脉冲信号干扰光,假设 Ω = 12 25 ω , *S*分 别等于 *F* 和 10*F*, $\theta_0 = 0$, $\varphi = \pi$,如图 3 α 图 3f所示,调 制盘系统接收到的目标信号受到严重干扰,目标信号 和干扰信号相互叠加而无法区别,由于产生严重的过 调制现象,理论计算的信号包络和实际信号包络不完 全吻合。实际信号包络在几个周期内呈现无规则起 伏,调制盘体系统将无法判断目标方位。另外,即使目 标位于调制盘中心,目标信号为一直流项,由于干扰信 号仍可通过系统的信号处理电路,因此,系统接受到的 目标方位信息并不为 0,干扰信号对调制盘系统仍起 作用。 $d-\Omega = 12.25\omega$, S = F $e-\Omega = 12.25\omega$, S = 10F

比较图 3h 图 3c和图 3e 图 3f中的 2组数据,对 于以干扰为目的红外对抗,单纯提高干扰光能量对干 扰效果的提升有限,这是由于在增加干扰辐射能量的 同时,干扰信号的直流项与目标信号相叠加,使调制盘 系统接受到的目标信号同时得到增强,反而更容易暴 露目标,但若干扰能量过低又难以实现干扰效果,故实 战中应选取近似等于目标辐射强度的干扰信号,以实 现干扰。

4 小 结

旭日式调制盘是最简单的调幅式调制盘,其上半 圆为目标像点调制区,由圆心角相同的透光与不透光 扇形相间配置而成,下半圆为半透明区。加入半透明 区可以抑制大面积背景对制导系统的影响,但却为于 扰辐射提供了窗口。文中对比了改变目标幅值和干扰 目标信号两种干扰方式,第1种是通过在目标上加载 红外辐射源以改变目标的辐射强度,第2种是向导引 头系统发射一定频率的红外光脉冲信号以干扰导引头 系统接受到的目标信号。计算表明,两种方式都具一 定干扰效果,前者使导引头获得的目标方位出现偏差, 但无法使目标完全摆脱导弹的跟踪,后者使目标信号 和干扰信号相互叠加而无法分辨从而使导弹失去目标 信息。实战中一般同时调制干扰光源的幅度和频率, 以实现更佳干扰效果。文中计算还表明,对于以干扰 为目的红外对抗,单纯提高干扰光能量会同时增强导 (下转第 624页) 响熔覆道的宽度,在冷基板上沉积时,由于基板的热沉 作用,熔覆道较窄;激光微沉积的工艺参数及热过程对 所沉积薄壁的层高、厚壁及壁厚均匀性有显著影响,在 合适的工艺条件下,沉积过程及熔池大小经过初始几 层沉积后可达到稳定;为得到壁厚均匀一致的薄壁零 件,在沉积初始几层要选择较低的扫描速度和送粉量; 采用连续往复扫描沉积薄壁时,由于两端的热作用时 间较长,所沉积层的高度和厚度较其它部位有所增加, 采用单方向扫描和激光开关控制可克服这一差异;采 用激光粉末微沉积工艺,可直接制备出壁厚在 0.4mm 的薄壁零件,沉积表面的粗糙度 R。约 104m;所沉积的 薄壁材料内部组织致密,晶粒细小,充分显示了激光微 沉积合金粉末技术在直接成形高精度的细小零件及小 尺寸零件表面激光熔覆方面独特的优势和发展潜力。

参考文献

- [1] ABBOTT D H, ARCELLA F G. Laser fom ing tilan ium components
 [J]. Advanced Materials& Processes 1998, 152(5): 29~ 30.
- [2] SCHWENDNER K J BANERJEE R, COLLINS P C et al. D irect laser deposition of alloys from elemental powderblends [J]. ScriptaM ateri alia, 2001, 45(10): 1123~1129
- [3] LEW IS G K, SCHL ENGER E. Practical considerations and capabilities for laser assisted directmetal deposition [J]. Materials& Design, 2000, 21 (4): 417~423

(上接第 620页)

引头接收到的目标信息, 近似等于目标辐射强度的┮❤ 扰信号, 已经可以实现干扰。

实战中使用较多的棋盘格式调制盘、放射形和螺 线形调制盘等^[10],相比于旭日式调制盘、其优点在于 具有更好的空间滤波能力和较小的盲区等,但它的目 标方位识别的原理与旭日式调制盘相同,所以文中所 述的干扰方式对它们同样有效。实战中还需要对来袭 导弹实施侦察以获得敌方导引头工作方式、工作频率 等信息以实施干扰。

参考文献

- WANG Y Zh. M od em m ilitary optical technology [M]. Beijing Science Press 2003 224~257(in Chinese).
- [2] YAO B Q WANG Y Zh WANG Q. D evelopment of mid-infrared optical parametric oscillator [J]. Laser Technology, 2002, 26(3): 217 ~ 220(in Chinese).
- $[\ 3]$ WAN Y, LAN G, SU X Zh et al H igh energy ou put complex cavity

- [4] WU X, LIANG J MEIJ et al. M icrostructures of laser-deposited Tri-6A F4V [J]. M aterials & Design, 2004, 25(2): 137 ~ 144
- [5] CHOI J CHANG Y. Characteristics of laser aided direct metal/material deposition process for tool steel [J]. International Journal of Marchine Tools and Manufacture 2005, 45(4~5): 597~607.
- [6] KEICHED M, SMUGERESKY J.E. The laser forming of metallic components using particulates materials [J]. Journal of M etals 1997, 49(5): 51~54
- [7] ARCELLA F G, FROES F H. Producing titanium aerospace compornents from powder using laser forming [J]. Journal of M etals, 2000, 52 (5): 28~ 30.
- [8] KOBRYN P A, MOORE E H, SEM ATN S L The effect of laser power and traverse speed on microstructure, porosity, and build height in laser-deposited Tir6A F4V [J]. Scripta M aterialia, 2000, 43 (4): 299 ~ 305.
- [9] PNKERTON A J LIL The significance of deposition point standoff variations in multiple layer coaxial laser cladding [J]. In termational Journal of Machine Tool and Manufacture, 2004, 44(6): 573 ~ 584
- [10] MAZUMDER J DUTTA D, KUKUCH IN et al Closed bop direct metal deposition art to part J]. Optics and Lasers in Engineering 2000, 34(4~6): 397-414.
- [11] HU D M, KOVACEV K, R Sensing modeling and control for laserbased additive manufacturing [J]. International Journal of M achine Tools and M anufacture 2003, 43 (1): 51~60
- [12] LIXY, QIX J ZENG X Y. Establishment and application of temper ature field model in laser micro-cladding [J]. Laser Technology 2005, 29(6): 561~564(in Chinese).

pump optical parametric oscillator in the mid infrared [J]. Laser Technology 2005, 29(4): 340~342(in Chinese).

- [4] YUAN Y H, LIU S H, SUN Ch W et al. The research es of laser disturbance effects in IR system processing circuit [J]. Laser Technology, 2002, 26(6): 432 ~ 434(in Chinese).
- [5] SUZUK IK. Analysis of rising- sun reticle [J]. OptEngng 1979, 18 (3): 350~351
- [6] SZU H H, KOPR NA I PERS N A. Independent component analysis approach to resolve the multi-source limitation of the nutating risingsun reticle based optical trackers [J]. Opt Commun, 2000, 176–77~ 89.
- [7] YANG Y H, YUE M. Infrared system [M]. Beijing NationalD effecte Industry Press 1985. 45~ 60(in Chinese).
- [8] WU Ch L, CHEN X, Q IU X H. R esearch of the photor electric jammer's jamming principle [J]. Journal of Xidian University, 1995, 22 (3): 290~294(in Chinese).
- [9] LISh X, WEIJY. Analysis of infrared jammer's jamming principle [J]. Infrared and Laser Technology, 1994 23 (1): 10~13 (in Chinese).
- [10] Y N D R Analysis of reticle for IR guidancem is ile hongying 5 [J]. Infrared and Laser Techology, 1995 24(4): 47~ 51 (in Chinese).